
2SC2899

シリコン NPN 三重拡散形

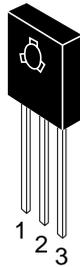
HITACHI

特長

- 高速度高電圧スイッチング用

外観図

TO-126 MOD



1. Emitter
2. Collector
3. Base

絶対最大定格

(Ta = 25)

項目	記号	2SC2899	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	400	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	10	V
コレクタ電流	I_C	0.5	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	1.0	A
許容コレクタ損失	P_C	0.75	W
許容コレクタ損失	P_C^{*1}	10	W
接合部温度	T_j	150	
保存温度	T_{stg}	-55 ~ +150	

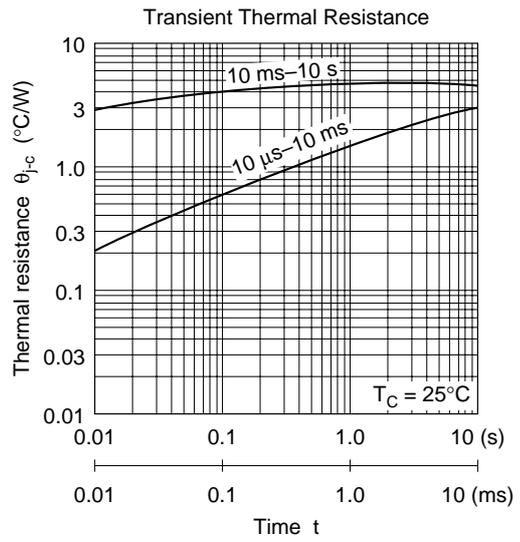
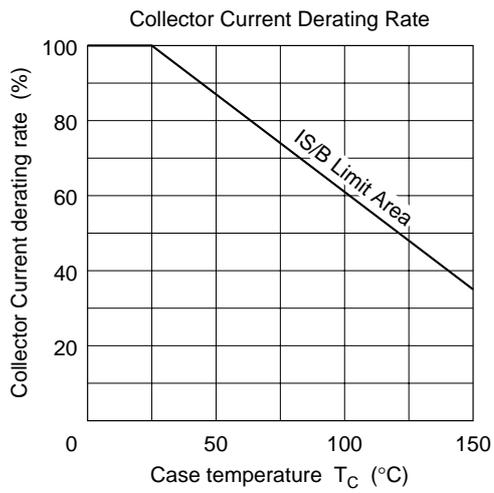
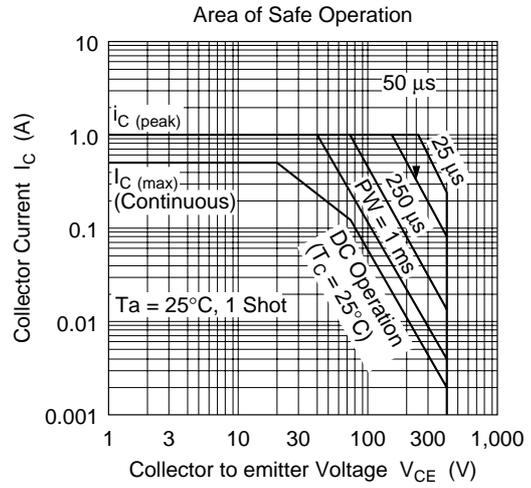
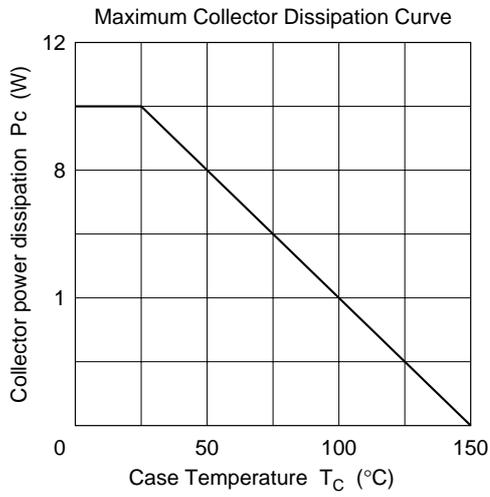
【注】 1. $T_C = 25$ における許容値

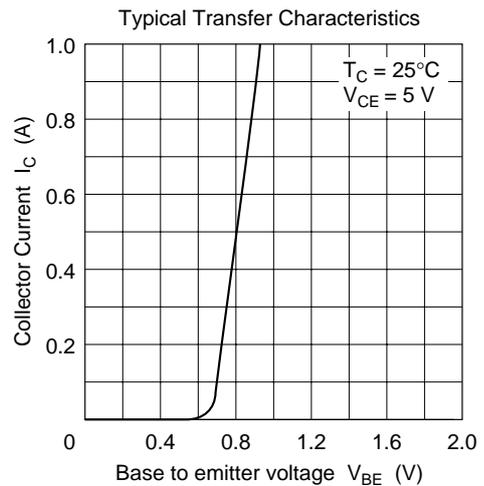
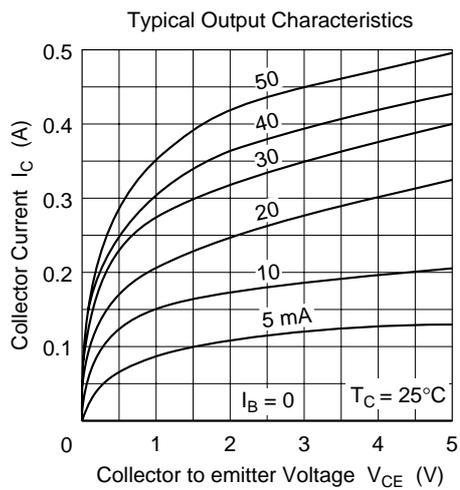
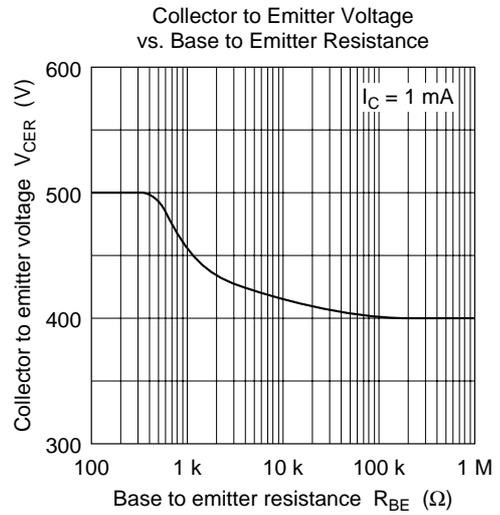
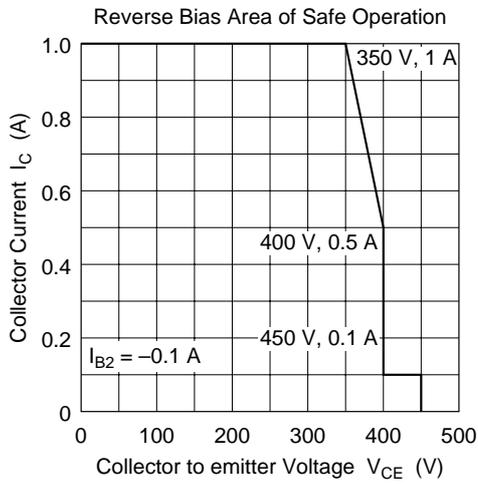
電気的特性

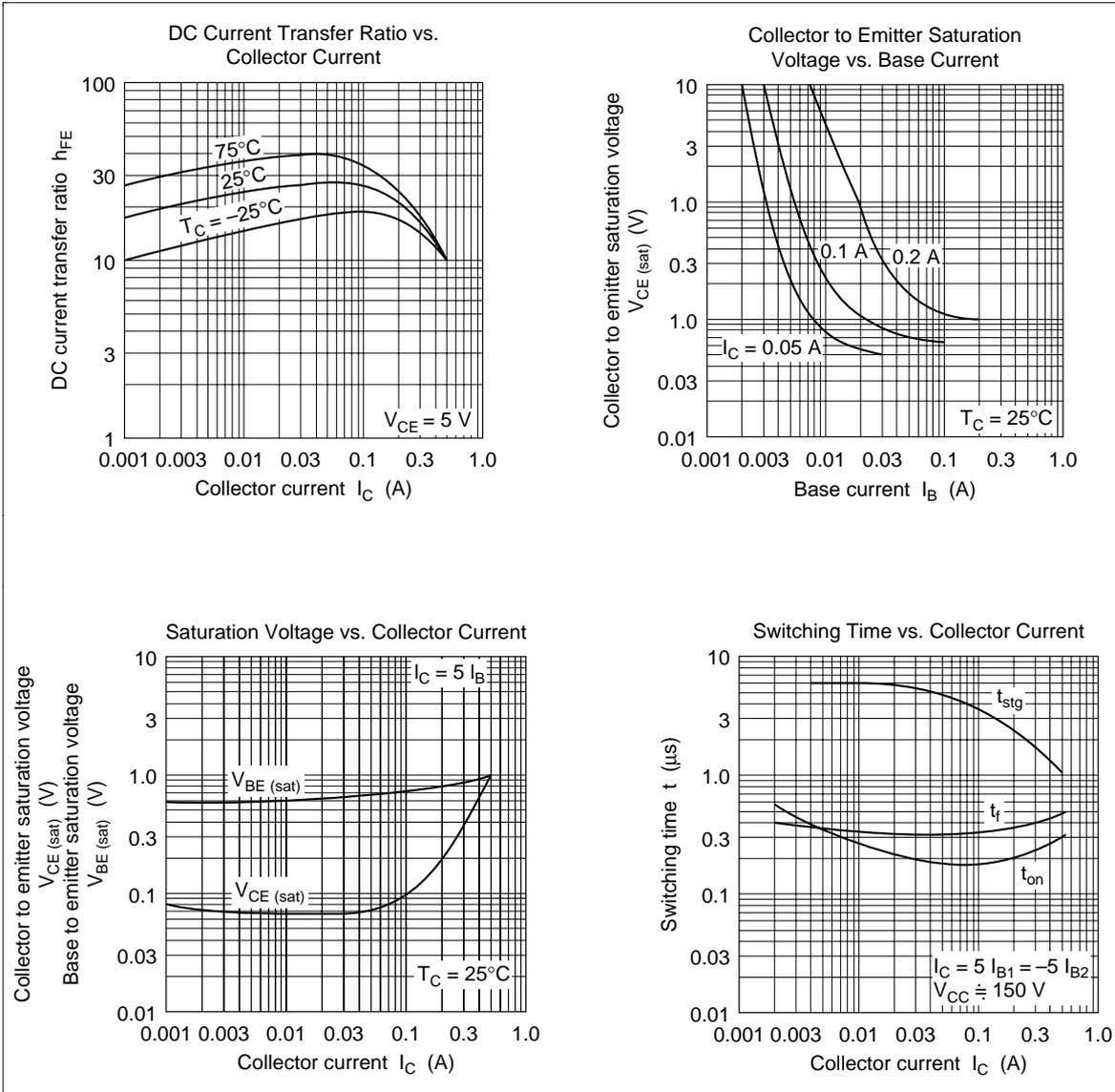
(Ta = 25)

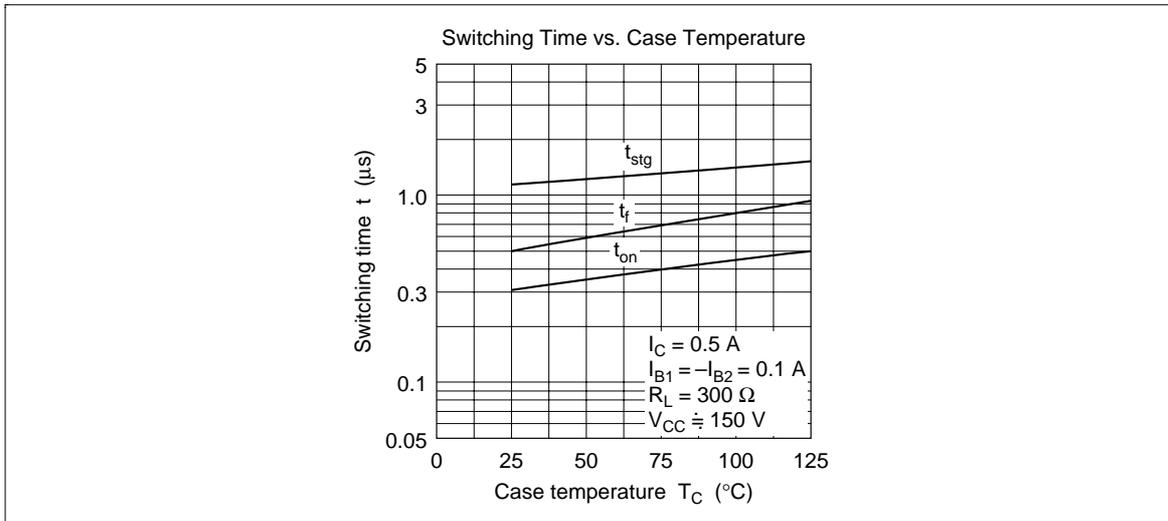
項目	記号	Min	Typ	Max	単位	測定条件
コレクタ・エミッタ維持電圧	$V_{CEO(sus)}$	400	—	—	V	$I_C = 0.1A$, $R_{BE} =$, $L = 100mH$
コレクタ・エミッタ維持電圧	$V_{CEX(sus)}$	400	—	—	V	$I_C = 0.5A$, $I_{B1} = -I_{B2} = 0.1A$, $V_{BE} = -5V$, $L = 180\mu H$, Clamped
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	10	—	—	V	$I_E = 10mA$, $I_C = 0$
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	—	—	20	μA	$V_{CB} = 400V$, $I_C = 0$
コレクタ遮断電流	I_{CEO}	—	—	50	μA	$V_{CE} = 350V$, $R_{BE} =$
直流電流増幅率	h_{FE1}	15	—	—		$V_{CE} = 5V$, $I_C = 0.25A^{*1}$
直流電流増幅率	h_{FE2}	7	—	—		$V_{CE} = 5V$, $I_C = 0.5A^{*1}$
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	—	1.0	V	$I_C = 0.25A$, $I_B = 0.05A^{*1}$
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	—	—	1.5	V	$I_C = 0.25A$, $I_B = 0.05A^{*1}$
ターンオン時間	t_{on}	—	—	1.0	μs	$I_C = 0.5A$, $I_{B1} = -I_{B2} = 0.1A$,
蓄積時間	t_{stg}	—	—	2.0	μs	$V_{CC} = 150V$
下降時間	t_f	—	—	1.0	μs	

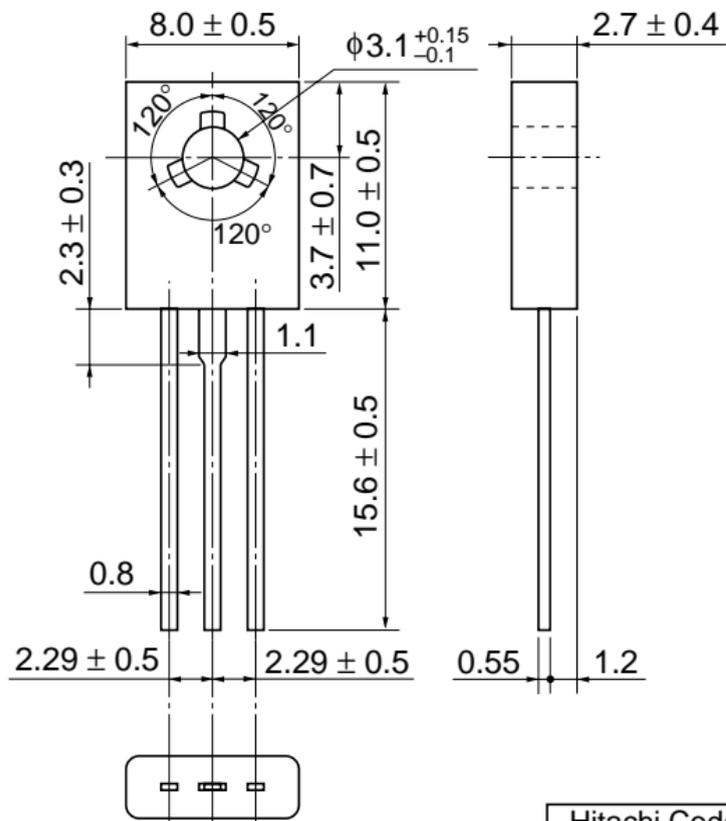
【注】 1. パルス測定











Hitachi Code	TO-126 Mod
JEDEC	—
EIAJ	—
Weight (reference value)	0.67 g